



DO-4
(CB-33)

Silicon rectifier diodes - normal series (continued)

Diodes de redressement au silicium - série normale (suite)

$t_{\text{case}} = 25^{\circ}\text{C}$

Type Type	Case Boîtier	V_{RRM} (V) max.	t_{vj} ($^{\circ}\text{C}$) max.	I_{O} (A) max.	I_{FSM} (A) $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ max.	V_{F} (V) max.	I_{F} (A)	$I_{\text{R}} / V_{\text{RRM}}$ (mA) max.	Data sheet in (see page 10) Notice dans (voir page 10)
*1N 1581	DO-4	50	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1582	DO-4	100	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1583	DO-4	200	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1584	DO-4	300	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1585	DO-4	400	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1586	DO-4	500	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*1N 1587	DO-4	600	+175	3 (2)	40 (2)	1,5	3	5 (4)	DRT 75
*42 R2	DO-4	200	+150	6 (3)	75 (4)	1,3	6	4,5 (4)	DRT 75
*44 R2	DO-4	400	+150	6 (3)	75 (4)	1,3	6	2,5 (4)	DRT 75
*46 R2	DO-4	600	+150	6 (3)	75 (4)	1,3	6	1,5 (4)	DRT 75
*48 R2	DO-4	800	+150	6 (3)	75 (4)	1,3	6	1 (4)	DRT 75
*62 R2	DO-4	200	+150	12 (3)	150 (4)	1,3	12	4,5 (4)	DRT 75
*64 R2	DO-4	400	+150	12 (3)	150 (4)	1,3	12	2,5 (4)	DRT 75
*66 R2	DO-4	600	+150	12 (3)	150 (4)	1,3	12	1,5 (4)	DRT 75
*68 R2	DO-4	800	+150	12 (3)	150 (4)	1,3	12	1 (4)	DRT 75

For anode connected to case add suffix R
Pour anode connectée au boîtier ajouter le suffixe R

*Preferred device
Dispositif recommandé

(1) $t_{\text{amb}} = 50^{\circ}\text{C}$ (2) $t_{\text{case}} = 150^{\circ}\text{C}$ (3) $t_{\text{case}} = 125^{\circ}\text{C}$ (4) $t_{\text{vj}} = 150^{\circ}\text{C}$